

TRANSISTORS PNP

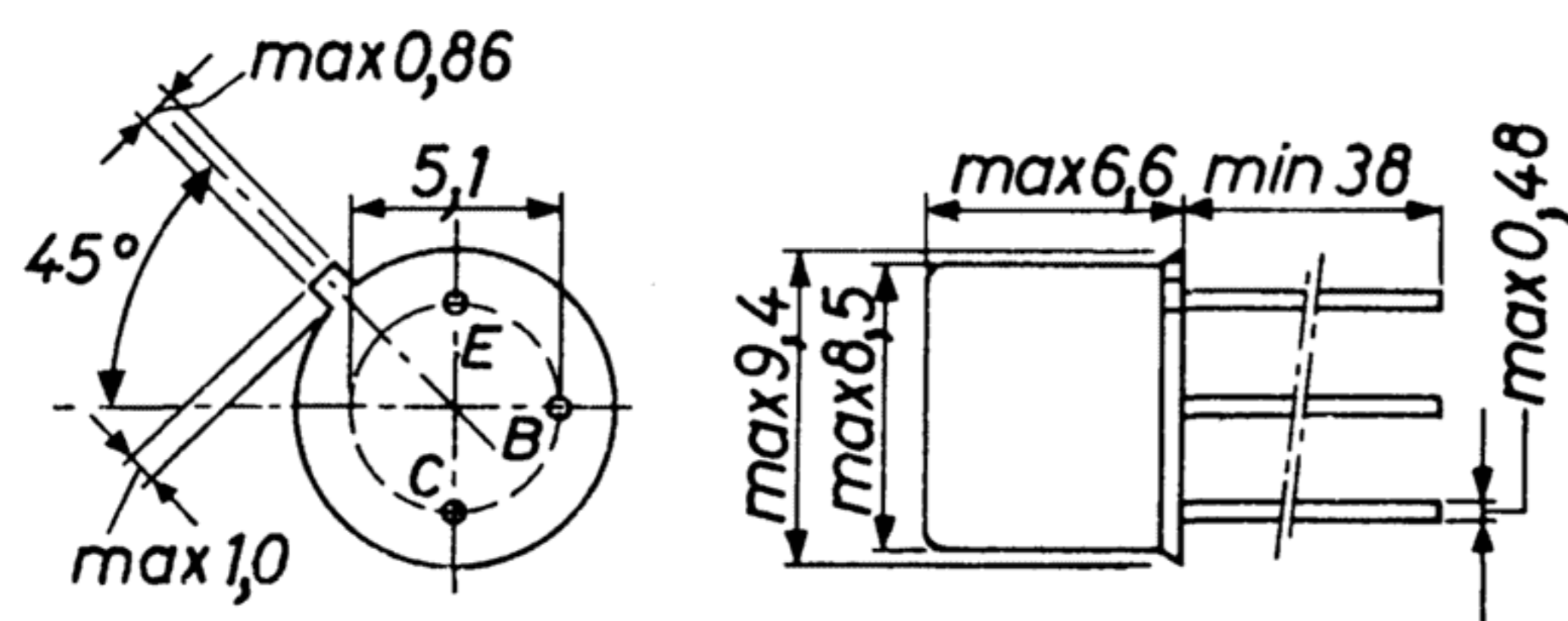
par alliage au silicium

BCY30
BCY31
BCY32
BCY33
BCY34

www.datasheetcatalog.com

Cette série de transistors est utilisée pour toutes applications professionnelles en basse fréquence et commutation lente à faible niveau. La tension V_{EB} est remarquable pour un PNP Silicium.

Disposition des électrodes
et encombrement



dimensions en millimètres

Boîtier JEDEC TO-5
connexions isolées du boîtier
poids : 0,9 g. environ



Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation	Symboles	BCY30 BCY31	BCY32	BCY33 BCY34	Unités
Tension collecteur base	V_{CB}	-64	-64	-32	V
Tension collecteur émetteur	V_{CE}	-50	-50	-25	V
Tension émetteur base	V_{EB}	-45	-32	-16	V
Courant crête de collecteur	I_{CM}	← -100 →			mA
Courant continu de collecteur	I_C	← -50 →			mA
Courant crête de base	I_{BM}	← -50 →			mA
Courant continu de base	I_B	← -15 →			mA
Caractéristiques thermiques					
Puissance de dissipation (jusqu'à $t_{case} = 62,5^\circ C$)	P_{tot}	← 250 →			mW
Température de jonction	t_j	← 150 →			$^\circ C$
Température de stockage	t_{stg}	← -55 à +150 →			$^\circ C$
Résistance thermique jonction-air ambiant	R_{th}	← 0,5 →			$^\circ C/mW$
Résistance thermique jonction-boitier	R_{th}	← 0,35 →			$^\circ C/mW$



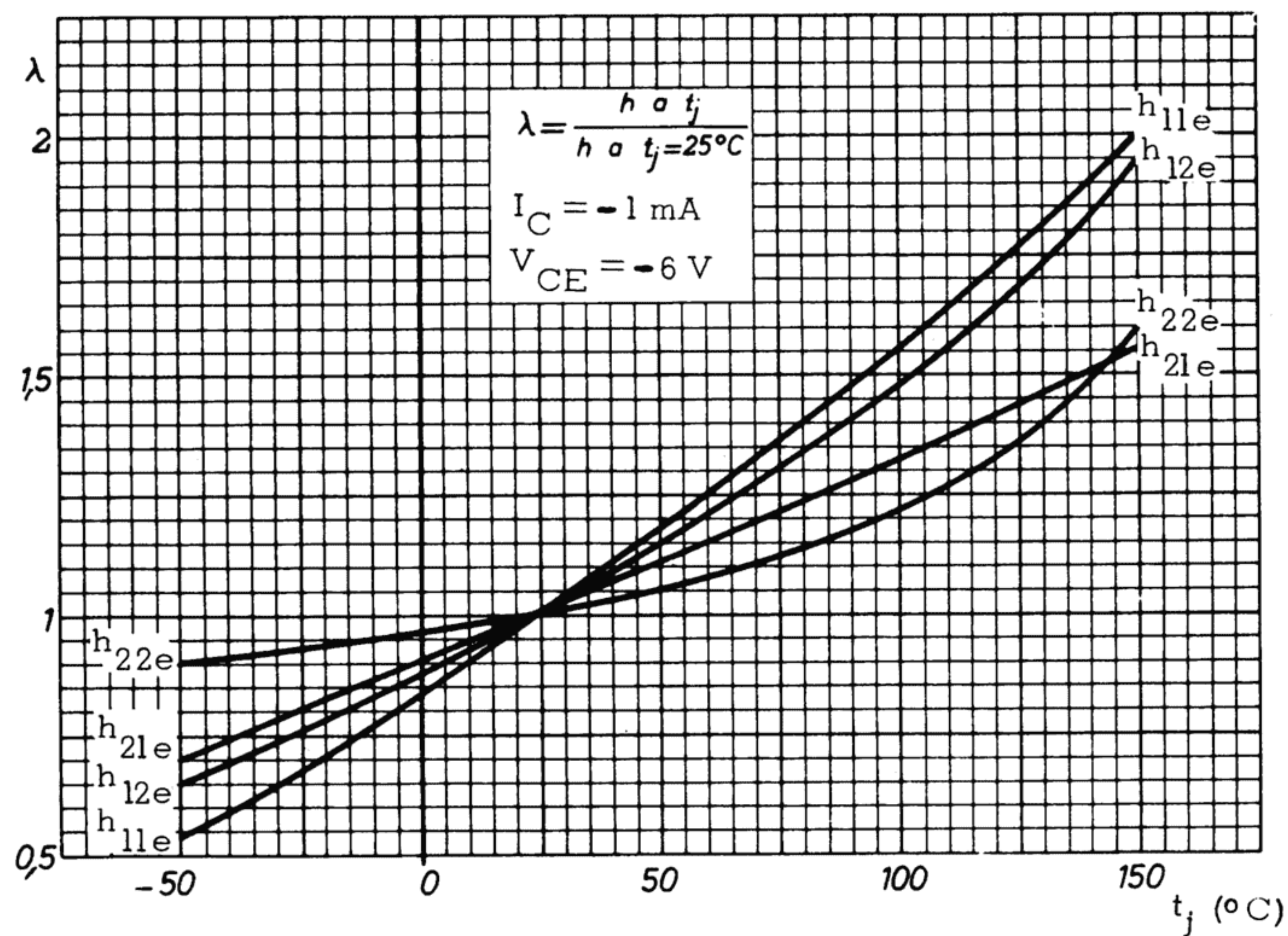
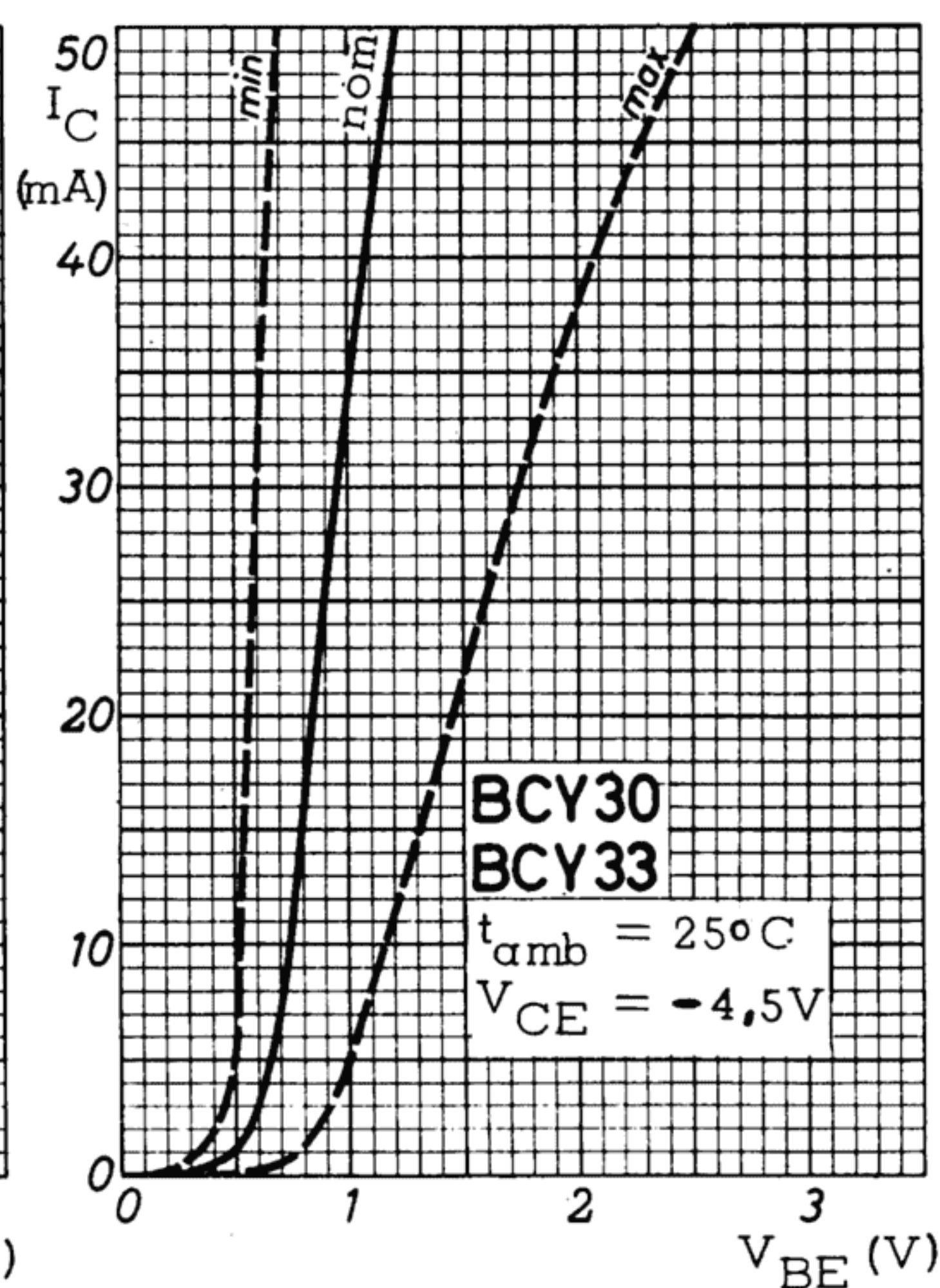
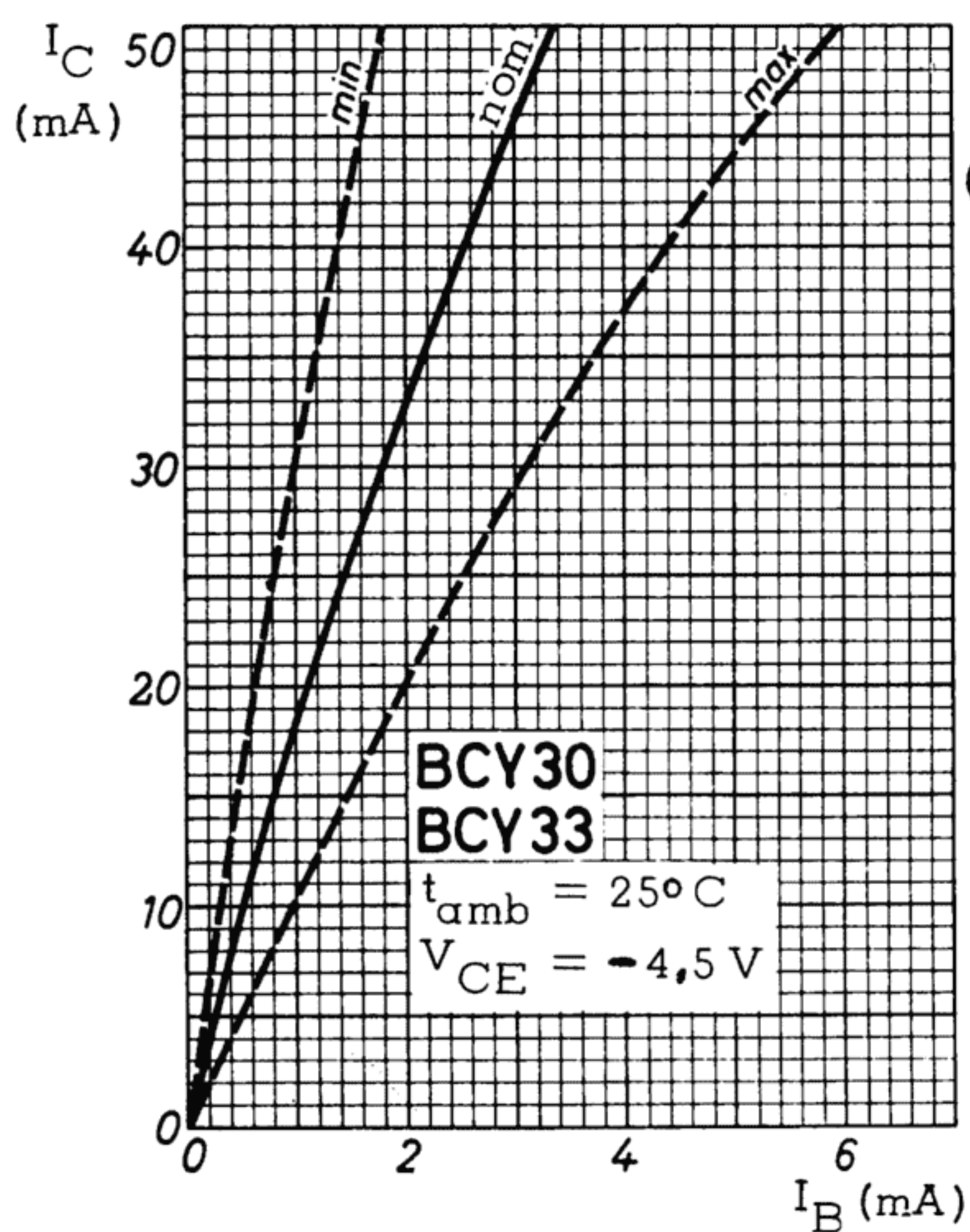
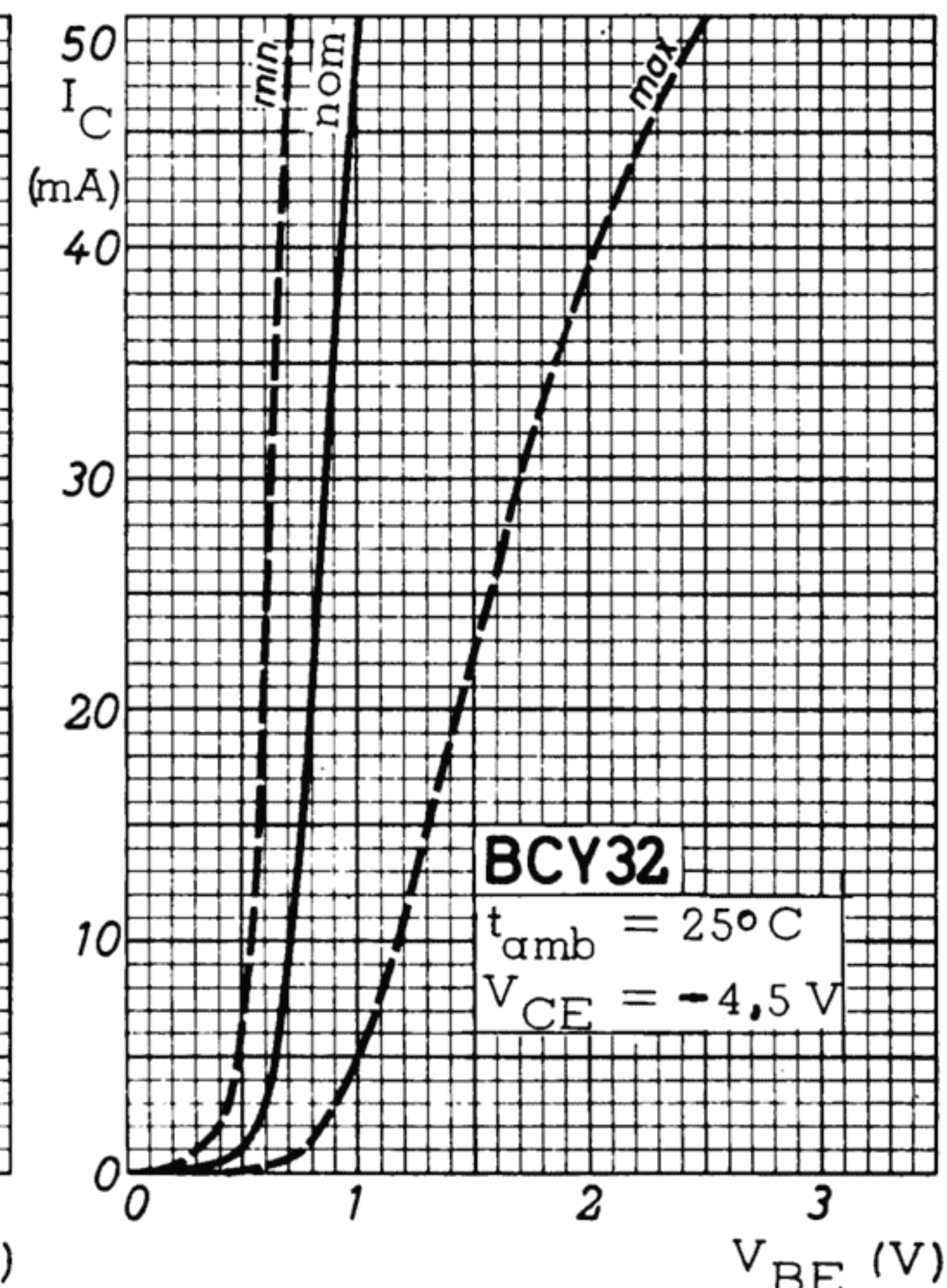
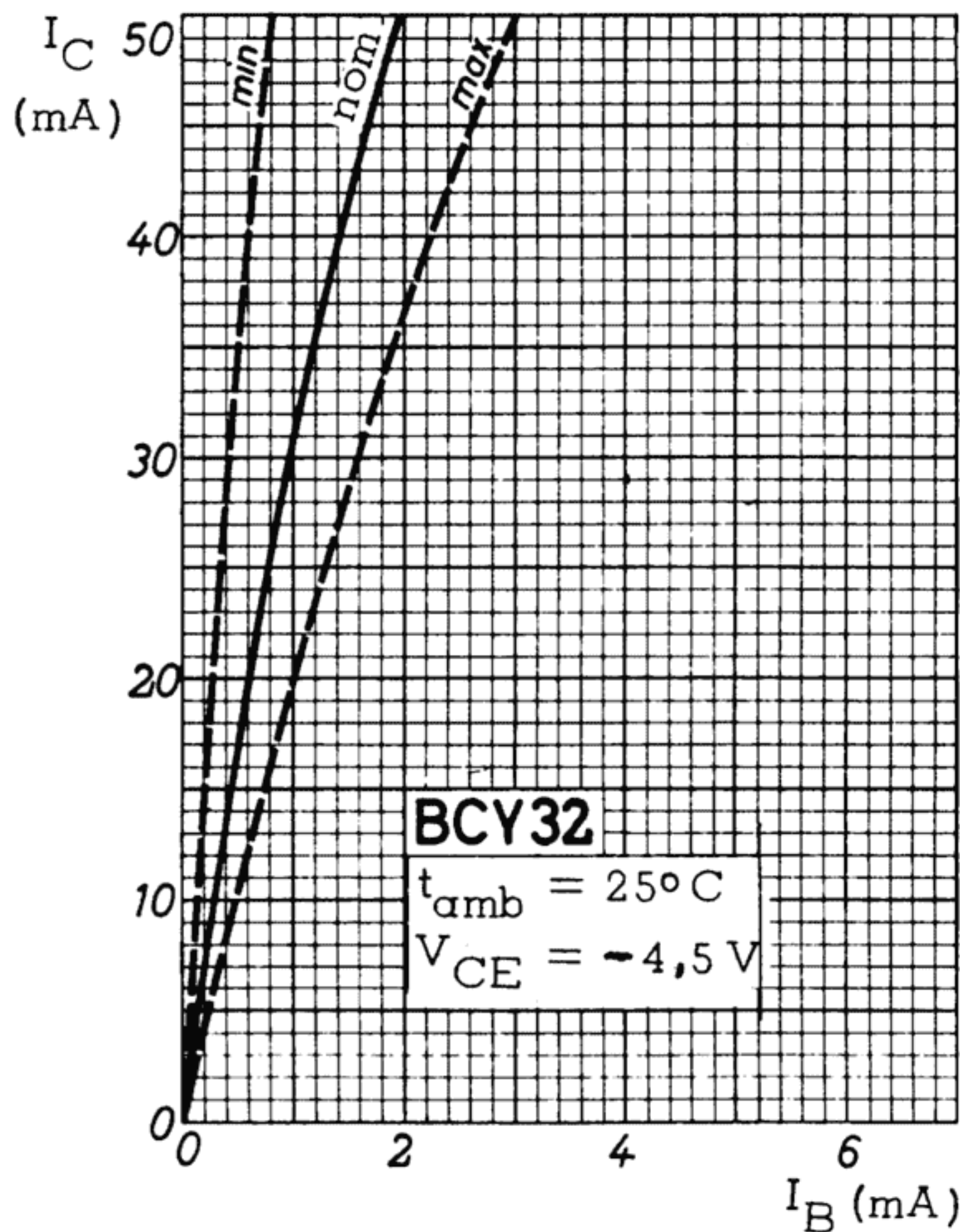
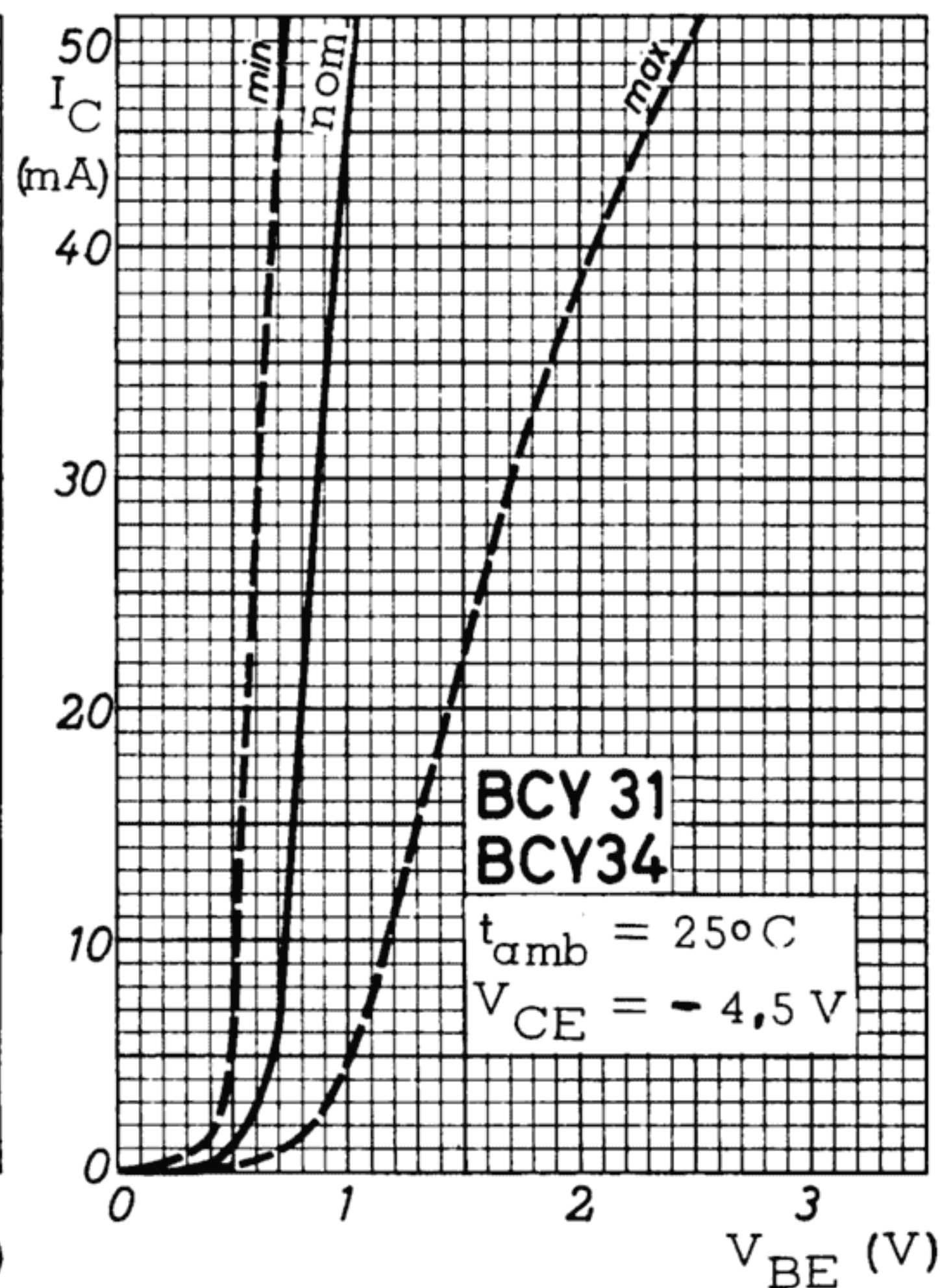
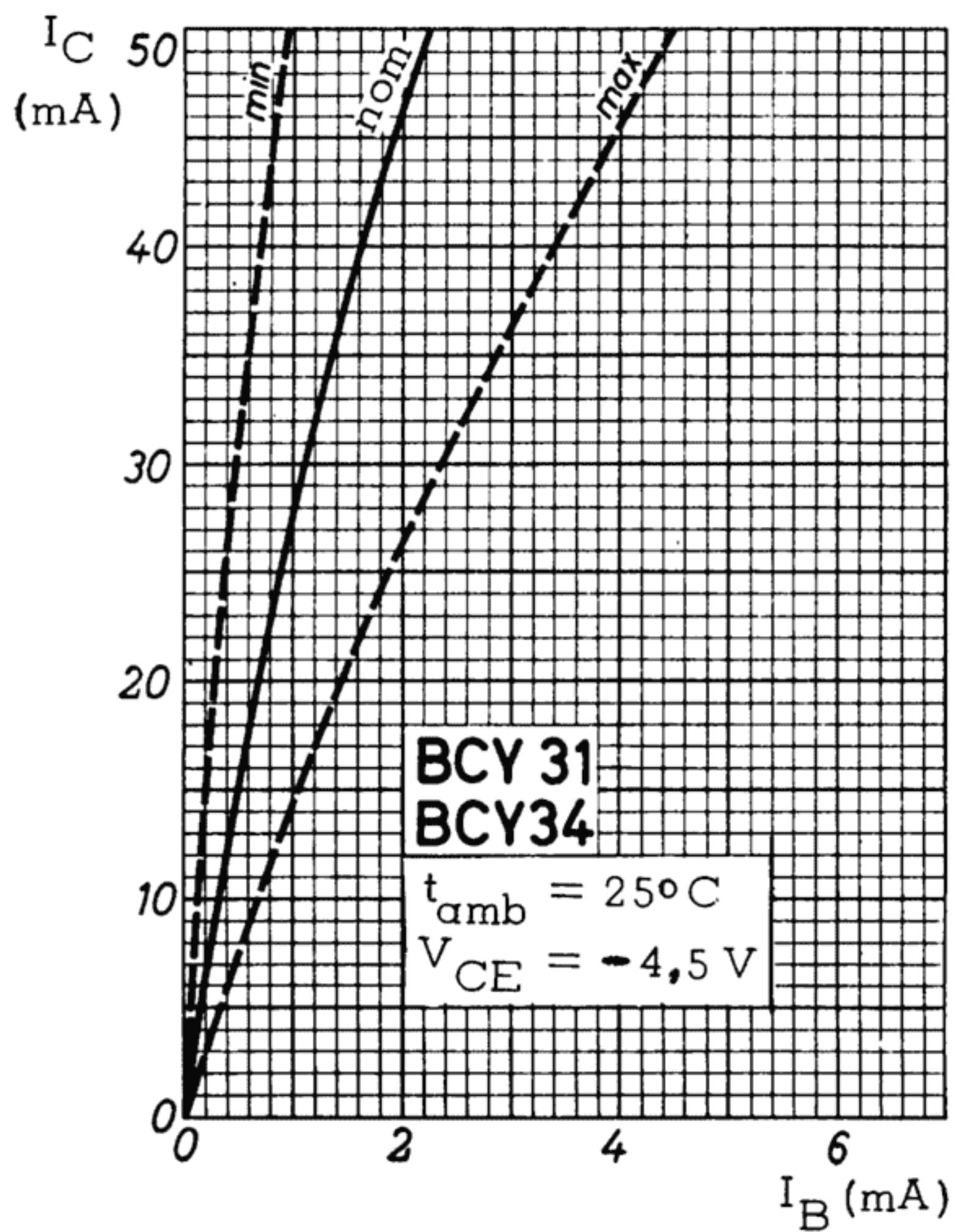
18, rue d'Enghien, 75 Paris 10^e - FRANCE - Tél : (1) 523 15-25 +

TELEX : 28.302 COMPLEC-PARIS

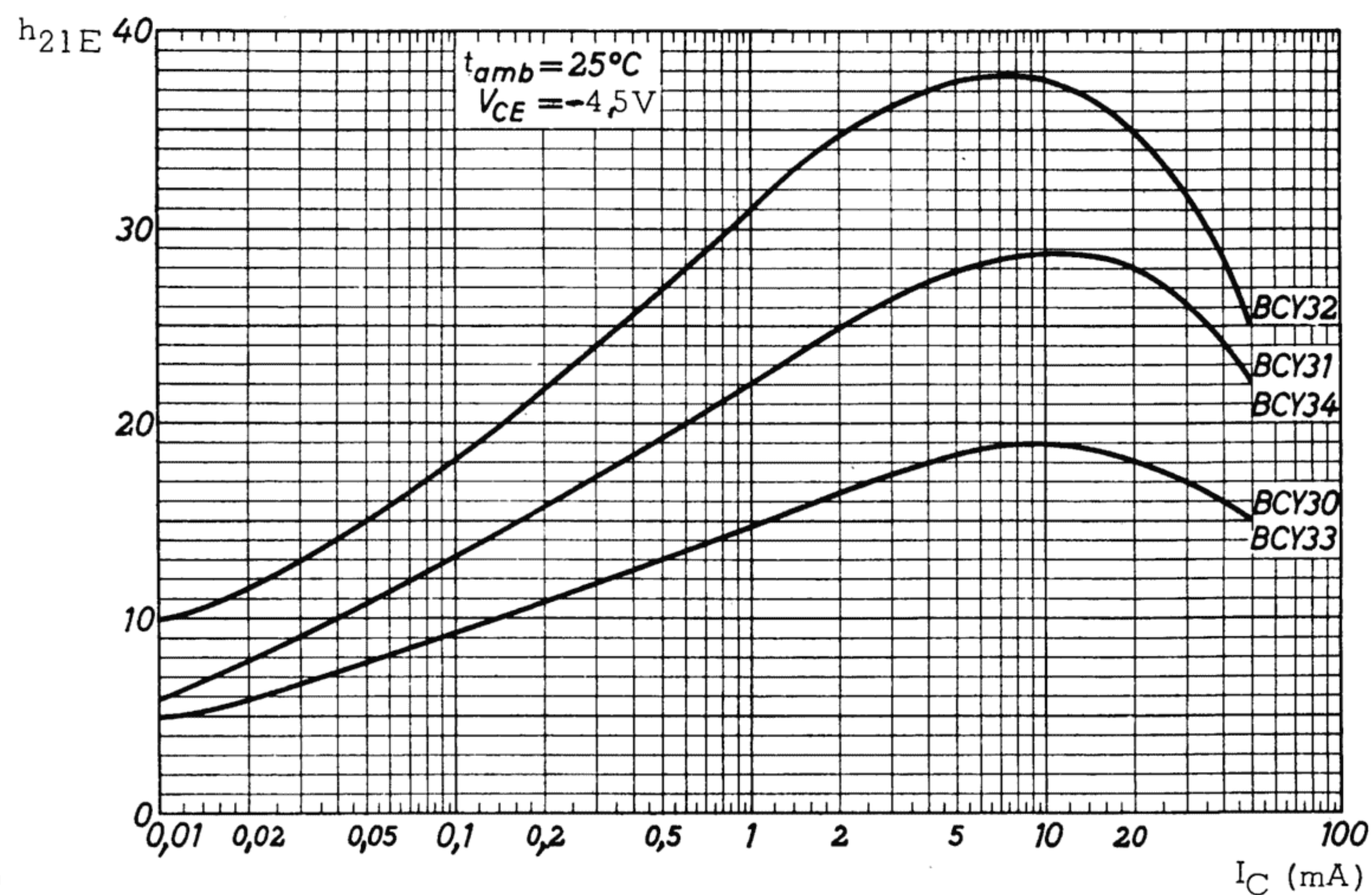
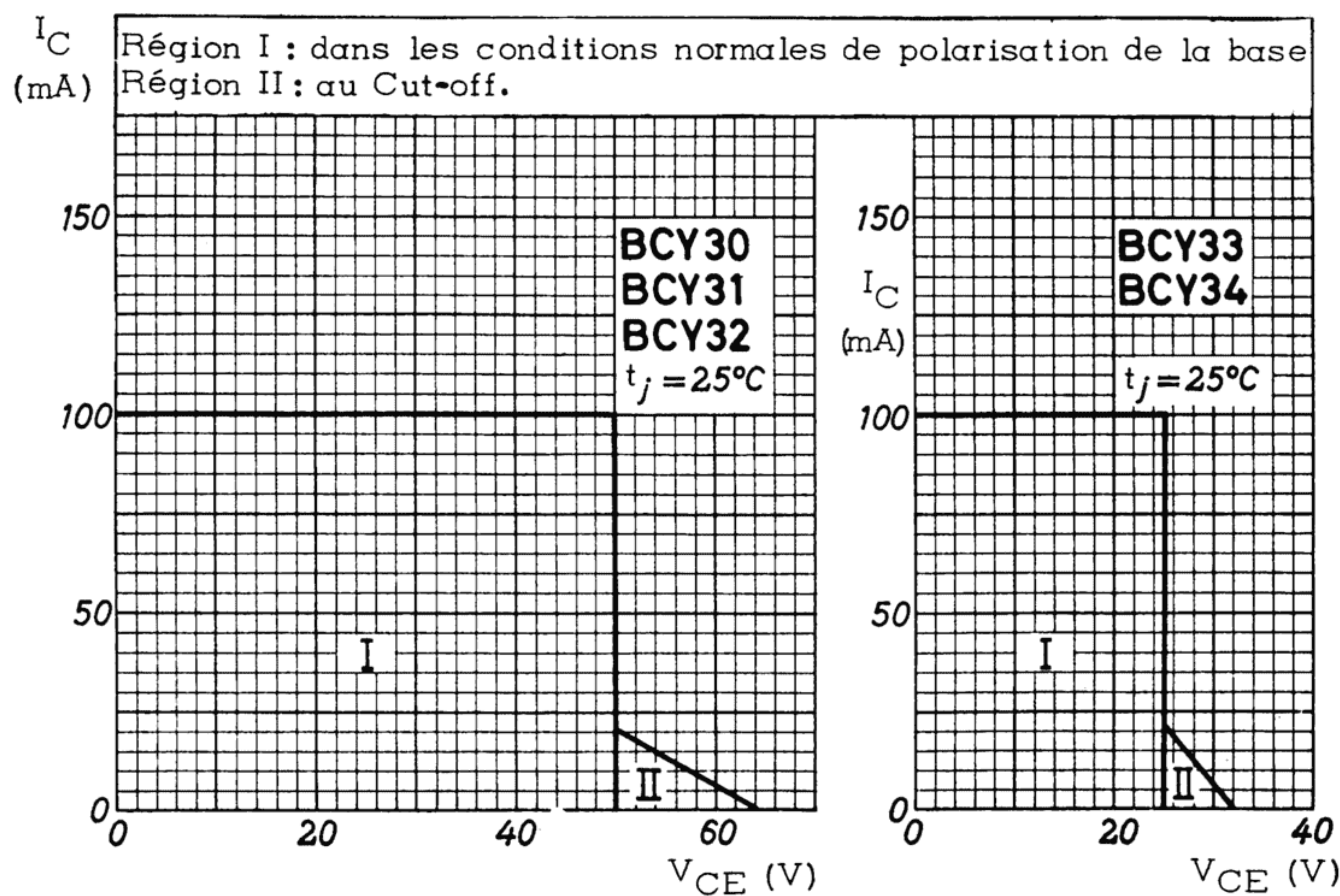
R. C. Seine 65 B 1604

BCY30
BCY31
BCY32
BCY33
BCY34

Caractéristiques statiques $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$	Conditions de mesure	Symboles	BCY30			BCY31			BCY32			BCY33			BCY34			Unités
			min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
Courant résiduel de collecteur	$V_{CB} = -6\text{V}, I_E = 0$	I_{CBO}	-1	-50		-1	-50		-1	-50		-1	-50		-1	-50	nA	
Courant résiduel d'émetteur	$V_{EB} = -6\text{V}, I_C = 0$	I_{EBO}	-1	-50		-1	-50		-1	-50		-1	-50		-1	-50	nA	
	$V_{EB} = -6\text{V}, I_C = 0, t_j = 100^{\circ}\text{C}$	I_{EBO}	-0,1	-2,5		-0,1	-2,5		-0,1	-2,5		-0,1	-2,5		-0,1	-2,5	μA	
Tension de saturation collecteur-émetteur	$I_C = -20\text{mA}, I_B = -3\text{mA}$	V_{CEsat}	-160	-550		-160	-550		-160	-550		-160	-550		-160	-550	mV	
Tension de saturation base-émetteur	$I_C = -20\text{mA}, I_B = -3\text{mA}$	V_{BEsat}	-0,8	-1,25		-0,8	-1,25		-0,8	-1,25		-0,8	-1,25		-0,8	-1,25	V	
Rapport de transfert direct du courant (gain statique)	$I_C = -20\text{mA}, V_{CE} = -4,5\text{V}$	h_{21E}	10	18	35	15	28	60	20	35	70	10	18	35	15	28	60	
Caractéristiques dynamiques ($t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)																	www.datasheetcatalog.com	
Capacité de collecteur	$V_{CB} = -6\text{V}, I_E = I_e = 0$	C_c	15	28	60	15	28	60	15	28	60	15	28	60	15	28	60	pF
Rapport de transfert direct du courant (gain dynamique)	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -1\text{mA}$ $f = 1\text{KHz}$	h_{21e}	15	25	35	25	35	60	35	55	80	15	25	35	25	35	60	
Facteur de bruit	$V_{CE} = -2\text{V}, I_E = 500\mu\text{A}$ $f = 1\text{KHz}, R_G = 500\Omega$	F		8	20		8	20		8	20		8	20		8	20	dB
Fréquence de transition	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -1\text{mA}$	f_T	0,25	1,2		0,25	1,7		0,25	2,5		0,4	1,5		0,6	2,4	MHz	
Impédance de base	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -1\text{mA}$ $f = 1\text{KHz}$	$ Z_{12b} $		160	500		220	500		230	500		190	500		235	500	Ω



www.datasheetcatalog.com



BCY30
 BCY31
 BCY32
 BCY33
 BCY34

